

仪器设备



- 微纳研究中心 ▶
- 重大装备实验中心 ▶
- 中小型设备中心 ▶
- 西安交大青岛研究院 ▶

首页 > 仪器设备 > 微纳研究中心 > 正文



中文名称: 管式生长炉
型号规格: CVD-09502/ CVD(D)-12/50/2
负责人: 李吉成
E-mail: lijicheng1956@126.com
生产厂商: 合肥日新, 中国
机器状态: 正常
对外服务: 否
联系电话: 029-83395005
所在地点: 曲江校区西五楼洁净室

主要性能指标:

技术参数: 1.A管高温区最高温度: 1650°C; 低温区最高温度: 1300°C 2.A管高温区工作温度: 1300-1500°C; 低温区工作温度: 1100-1250°C 3.B管高温区最高温度: 1100°C; 低温区最高温度: 1100°C 4.B管高温区工作温度: 800~1050°C; 低温区工作温度: 800~1050°C 5.控温精度: ±1°C 主要特点 1.A炉管实际尺寸: Φ90 (外径) ×1450mm (石英) 2.B炉管实际尺寸: Φ120 (外径) ×1450mm (刚玉) 3.进口单回路智能温度控制仪PID参数自整定、超温、欠温、断偶报警保护 4.加热元件: 优质U型硅钼棒 (1800型)、进口KTL电阻丝 5.真空工作模式 6.多种工艺气路, 实现多种薄膜材料制备

主要功能:

设备简介: 专门设计用于高(低)温CVD工艺。如ZnO纳米结构的可控生长、氮化硅渡膜、陶瓷基片导电率测试、陶瓷电容器 (MLCC) 的气氛烧结等。